

《21世纪高等院校规划教材》

图书基本信息

书名：《21世纪高等院校规划教材》

13位ISBN编号：9787113133528

10位ISBN编号：7113133525

出版时间：2011-8

出版社：于天河、蒋少禹 中国铁道出版社 (2011-08出版)

页数：159

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《21世纪高等院校规划教材》

内容概要

《21世纪高等院校规划教材:微机原理与接口技术习题解答及实验指导》共分5篇,主要内容包括教学内容指导(包括知识点回顾与主教材习题答案)、综合模拟试题及参考答案、汇编语言实验环境及上机过程、汇编语言程序设计实验指导、硬件接口电路实验指导。

书籍目录

第一篇教学内容指导 第1章 概述 1.1知识点回顾 1.2主教材习题答案 第2章 微处理器系统 2.1知识点回顾 2.2主教材习题答案 第3章 寻址方式和指令系统 3.1 知识点回顾 3.2 主教材习题答案 第4章 汇编语言程序设计 4.1知识点回顾 4.2 主教材习题答案 第5章 存储器系统 5.1 知识点回顾 5.2主教材习题答案 第6章 输入，输出和总线技术 6.1 知识点回顾 6.2主教材习题答案 第7章 中断 7.1 知识点回顾 7.2主教材习题答案 第8章 常用数字接口芯片 8.1知识点回顾 8.2主教材习题答案 第9章A / D和D / A转换 9.1 知识点回顾 9.2 主教材习题答案 第二篇综合试题及参考答案 综合试题1 综合试题2 综合试题3 综合试题4 综合试题1 参考答案 综合试题2 参考答案 综合试题3 参考答案 综合试题4 参考答案 第三篇汇编语言实验环境及上机过程 第1章 汇编语言程序设计的实验环境和上机过程简介 第2章应用案例 第3章 开发环境所需文件功能详解 第四篇 汇编语言程序设计实验指导 实验1 TD调试程序的使用及寻址方式实验 实验2 算术运算、逻辑运算和移位指令实验 实验3 串操作指令实验 实验4顺序程序结构设计实验 实验5 两个数相乘实验 实验6 分支及循环程序设计实验 实验7排序实验 实验8综合设计实验 第五篇硬件接口电路实验指导 实验1 8255可编程并行接口实验 实验2 8253可编程定时器 / 计数器实验 实验3 8251可编程串行接口实验 实验4 8259可编程中断控制器实验 实验5 存储器扩展实验 实验6 D / A转换接口实验 实验7 A/D转换接口实验 实验8 步进电机控制实验 附录A TD使用说明 参考文献

章节摘录

版权页：插图：12.和外存相比，内存的特点是A。A.容量小、速度快、成本高 B.容量小、速度快、成本低 C.容量大、速度快、成本高 D.容量大、速度快、成本低 13.采用虚拟存储器的目的是C。A.提高存储的速度 B.扩大外存的容量 C.扩大内存的存储空间 D.提高外存的速度

二、填空题 1.存储器是计算机系统中的存储装置，用来存放数据和程序。2.存储器的两个基本操作是读和写。3.对容量为 2^n B的存储单元的存储矩阵，需要n位地址线连通对应存储单元。4.1位地址经地址译码器译码后能寻址2个存储单元。5.一般微型计算机存储器系统主要由主存储器、高速缓冲存储器、辅助存储器以及管理这些存储器的硬件和软件组成。6.微型计算机主存储器由半导体存储器RAM和ROM组成。7.RAM是一种既能写入又能读出的存储器。RAM只能在电源电压正常时工作，一旦断电，信息会丢失。8.ROM是一种只读的存储器，通常用来存放那些固定不变、不需要修改的程序。9.高速缓冲存储器是介于CPU和主存储器之间的一个容量小、但速度接近于CPU的存储器，一般装在CPU内部。10.Cache中保存的是CPU最近时间常用的信息，而不是在主存中驻留的信息。

三、简答题 1.半导体存储器有哪些优点？SRAM、DRAM各自有何特点？【答】其优点是容量大、存取速度快、体积小、功耗低、集成度高、价格便宜。SRAM存放的信息在不停电的情况下能长时间保留不变，只要不掉电所保存的信息就不会丢失。而DRAM保存的内容即使在不掉电的情况下隔一定时间后也会自动消失，因此要定时对其进行刷新。2.ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash Memory各有何特点？适用于何种场合？【答】掩膜式ROM中的信息是在生产厂家制造时写入的。制成后，信息只能读出不能改写。PROM中晶体管的集电极接 V_{cc} ，基极连接行线，发射极通过一个熔丝与列线相连。出厂时，晶体管阵列的熔丝完好。写入信息时，选中某个晶体管，输入高低电平保留或烧断熔丝以对应1和0。烧断熔丝不能再复原，因此只能进行一次编程。EPROM芯片的顶部开有一石英窗口，通过紫外线的照射可擦除片内原有信息，一块芯片可多次使用，缺点是只能进行整片写。EEPROM是可用电擦除和编程的只读存储器，能在线读写，断电情况下信息不丢失，能随机改写；其擦写次数可达1万次以上，数据可保存10年以上。可作为系统中可靠保存数据的存储器。Flash Memory是新型的半导体存储器，可实现大规模电擦除，擦除功能可迅速清除整个存储器的所有内容；可高速编程；闪速存储器可重复使用，适用于文件需要经常更新的可重复编程应用中。对于需要实施代码或数据更新的嵌入式应用是一种理想的存储器。

《21世纪高等院校规划教材》

编辑推荐

《21世纪高等院校规划教材:微机原理与接口技术习题解答及实验指导》习题丰富,便于学生复习和自学;实验部分脱离了固定的实验箱限制,可操作性强。《21世纪高等院校规划教材:微机原理与接口技术习题解答及实验指导》适合作为高等学校微机原理与接口技术等相关课程的配套教材和参考用书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com